

【1000 ~ 2000万円】Power Device Design Senior Engineer

外資系デバイスメーカーでの募集です。 電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓...

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
外資系デバイスメーカー

Job ID
1586991

Industry
Communication

Company Type
International Company

Job Type
Permanent Full-time

Location
Osaka Prefecture

Salary
10 million yen ~ 20 million yen

Work Hours
09:00 ~ 18:00

Holidays
詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

Refreshed
November 28th, 2026 09:00

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Business Level

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2224778】
・高性能パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）のデザイン開発とテスト検証を担当し、プロセスチームと協力してデバイス加工とプロセスの最適化を行う。
・高性能パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の個別技術をフォローアップし、既存のデバイスの性能を向上させ、パテントポートフォリオを提案して実現させる。

Required Skills

必須要件
・半導体/電子/物理などの関連分野を専攻し、5年以上のパワーデバイスのデザイン開発経験（直近の3年間には関連のデザイン開発の従事が必須）、または優秀な博士課程の新卒者。
・パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の基本構造とデバイスシミュレーションデザイン方法に精通し、TCADソフトやレイアウトソフトを使用しデバイスデザインが得意な方。
・良好なコミュニケーション能力があり、異なる地域や異なる文化背景のチームと良好なコミュニケーションがとれる方。

Company Description

ご紹介時にご案内いたします